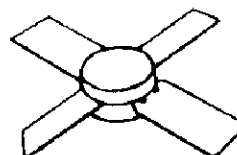


RF & MICROWAVE TRANSISTORS AVIONICS APPLICATIONS

- DESIGNED FOR HIGH POWER PULSED IFF, DME, TACAN APPLICATIONS
- 20 W (typ.) IFF 1030 - 1090 MHz
- 15 W (min.) DME 1025 - 1150 MHz
- 15 W (typ.) TACAN 960 - 1215 MHz
- REFRACTORY GOLD METALLIZATION
- EMITTER BALLASTED AND LOW THERMAL RESISTANCE FOR RELIABILITY AND RUGGEDNESS
- 20:1 LOAD VSWR CAPABILITY @ SPECIFIED OPERATING CONDITIONS
- INPUT MATCHED, COMMON BASE CONFIGURATION

DESCRIPTION

The SD1528-06 is a gold metallized epitaxial silicon NPN power transistor. The SD1528-06 is designed for applications requiring high peak power and low duty cycles such as IFF, DME and TACAN. The SD1528-06 is packaged in the .280" input matched stripline package, resulting in improved broadband performance and low thermal resistance.



.280 4 LFL (M115)
epoxy sealed

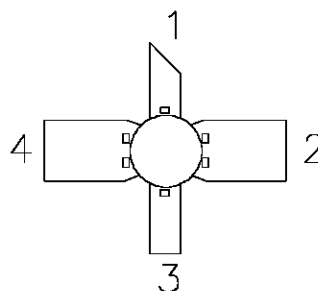
ORDER CODE

SD1528-06

BRANDING

1528-6

PIN CONNECTION



- | | |
|--------------|------------|
| 1. Collector | 3. Emitter |
| 2. Base | 4. Base |

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_{case} = 25^{\circ}C$)

Symbol	Parameter	Value	Unit
V_{CBO}	Collector-Base Voltage	65	V
V_{CES}	Collector-Emitter Voltage	65	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage	3.5	V
I_C	Device Current	1.5	A
P_{DISS}	Power Dissipation	87.5	W
T_J	Junction Temperature	+200	$^{\circ}C$
T_{STG}	Storage Temperature	- 65 to +150	$^{\circ}C$

THERMAL DATA

$R_{TH(j-c)}$	Junction-Case Thermal Resistance	2.0	$^{\circ}C/W$
---------------	----------------------------------	-----	---------------

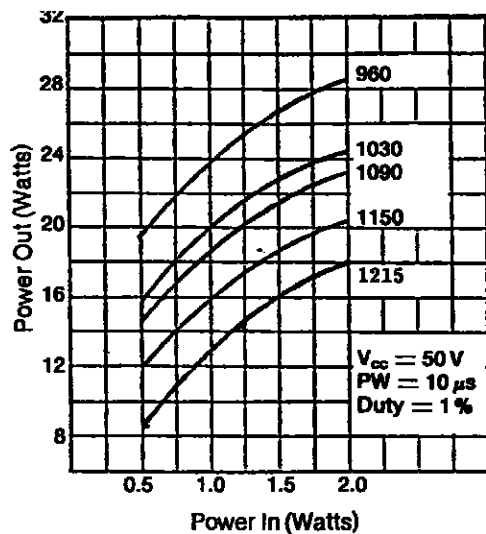
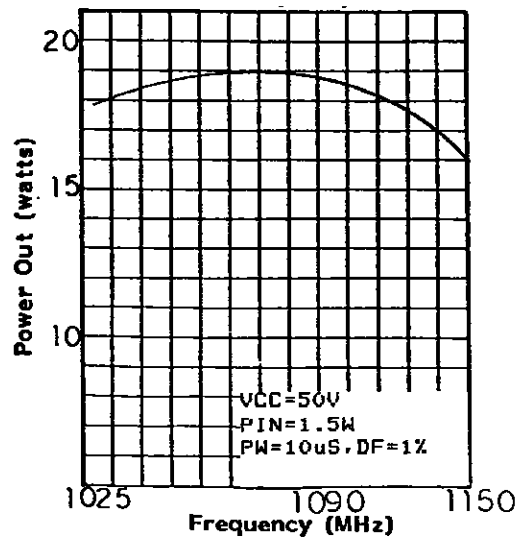
ELECTRICAL SPECIFICATIONS ($T_{\text{case}} = 25^{\circ}\text{C}$)**STATIC**

Symbol	Test Conditions	Value			Unit
		Min.	Typ.	Max.	
BV_{CBO}	$I_C = 10\text{mA}$ $I_E = 0\text{mA}$	65	—	—	V
BV_{CES}	$I_C = 25\text{mA}$ $V_{BE} = 0\text{V}$	65	—	—	V
BV_{EBO}	$I_E = 1\text{mA}$ $I_C = 0\text{mA}$	3.5	—	—	V
I_{CES}	$V_{CE} = 50\text{V}$ $I_E = 0\text{mA}$	—	—	2	mA
h_{FE}	$V_{CE} = 5\text{V}$ $I_C = .1\text{A}$	10	—	200	—

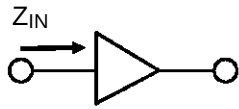
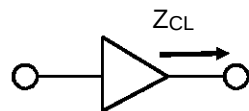
DYNAMIC

Symbol	Test Conditions	Value			Unit
		Min.	Typ.	Max.	
P_{OUT}	$f = 1025 \text{ — } 1150\text{MHz}$ $P_{IN} = 1.5 \text{ W}$ $V_{CE} = 50 \text{ V}$	15	—	—	W
G_P	$f = 1025 \text{ — } 1150\text{MHz}$ $P_{IN} = 1.5 \text{ W}$ $V_{CE} = 50 \text{ V}$	10	—	—	dB
η_c	$f = 1025 \text{ — } 1150\text{MHz}$ $P_{IN} = 1.5 \text{ W}$ $V_{CE} = 50 \text{ V}$	30	—	—	%

Note: Pulse Width = 10 μ sec, Duty Cycle = 1%

TYPICAL PERFORMANCE**POWER OUTPUT vs POWER INPUT****POWER OUTPUT vs FREQUENCY**

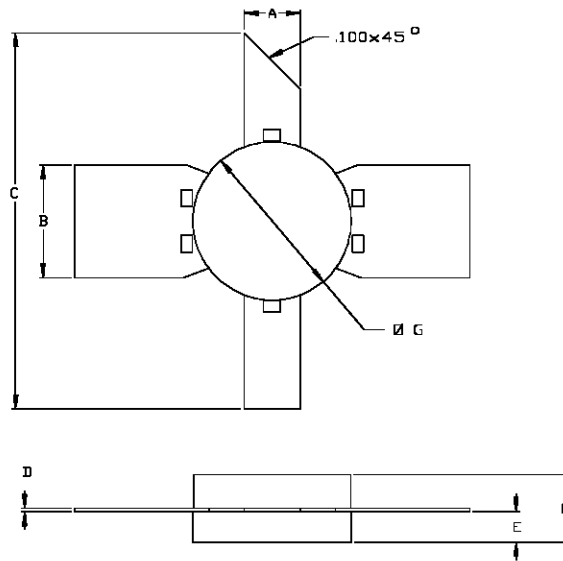
IMPEDANCE DATA

TYPICAL INPUT
IMPEDANCETYPICAL COLLECTOR
LOAD IMPEDANCE

FREQ.	$Z_{IN} (\Omega)$	$Z_{CL} (\Omega)$
960 MHz	$2.5 + j 12.5$	$17.0 + j 15.5$
1030 MHz	$3.5 + j 12.5$	$17.0 + j 14.5$
1090 MHz	$3.0 + j 13.5$	$19.5 + j 12.5$
1150 MHz	$3.5 + j 14.0$	$18.0 + j 12.0$
1215 MHz	$5.0 + j 17.0$	$16.0 + j 12.0$

PACKAGE MECHANICAL DATA

Ref.: Dwg. No.12-0115



SGS-THOMSON MICROELECTRONICS		
	MINIMUM Inches/mm	MAXIMUM Inches/mm
A	.095/2,41	.105/2,67
B	.195/4,95	.205/5,21
C	1.000/25,40	
D	.004/0,10	.007/0,18
E	.050/1,27	.065/1,65
F		.145/3,68
G	.275/6,99	.285/7,21

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, SGS-THOMSON Microelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of SGS-THOMSON Microelectronics. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. SGS-THOMSON Microelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of SGS-THOMSON Microelectronics.

© 1994 SGS-THOMSON Microelectronics - All Rights Reserved

SGS-THOMSON Microelectronics GROUP OF COMPANIES
 Australia - Brazil - France - Germany - Hong Kong - Italy - Japan - Korea - Malaysia - Malta - Morocco - The Netherlands -
 Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - Taiwan - Thailand - United Kingdom - U.S.A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9